



## 2SB1412 (3CA1412)

## 硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

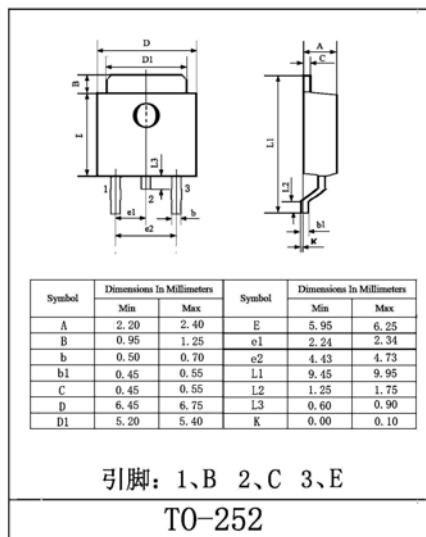
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点：饱和压降低，极好的直流电流增益特性，与 2SD2118 (3DG2118) 互补。

Features: Low  $V_{CE(sat)}$ , excellent DC current gain characteristics, complements the 2SD2118(3DG2118).

极限参数/Absolute maximum ratings( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	-30	V
$V_{CE0}$	-20	V
$V_{EB0}$	-6.0	V
$I_C$	-5	A
$I_{CM}$	-10	A
$P_C$	1.0	W
$*P_C (T_c=25^\circ\text{C})$	10	W
$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



\*mounted On40×40×0.7mm ceramic board.

\*贴装于 40×40×0.7mm 的陶瓷板上。

电性能参数/Electrical characteristics( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CB0}$	$I_C=-50\mu\text{A}$ $I_E=0$	-30			V
$V_{CE0}$	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-20			V
$V_{EB0}$	$I_E=-50\mu\text{A}$ $I_C=0$	-6.0			V
$I_{CB0}$	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
$I_{EB0}$	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$	82		390	
$*V_{CE(sat)}$	$I_C=-4.0\text{A}$ $I_B=-0.1\text{A}$			-1.0	V
$f_T$	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-50\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$		120		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		60		pF

\*:measured using pulse current.

\*:脉冲测试

$h_{FE}$  分档/ $h_{FE}$  Classifications: P: 82~180    Q: 120~270    R: 180~390



# 2SB1412 (3CA1412)

